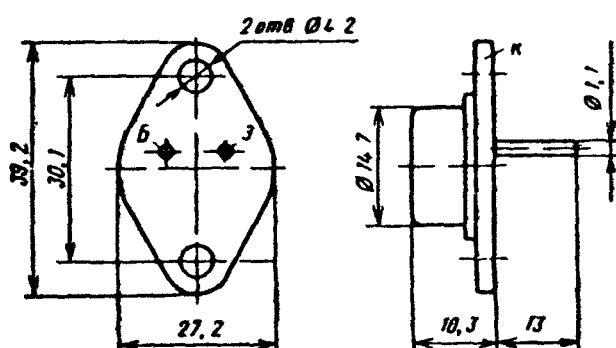


КТ848А

Транзистор кремниевый мезопланарный структуры *п-р-п* усилительный. Предназначен для применения в электронных системах зажигания. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г

КТ848А



Электрические параметры

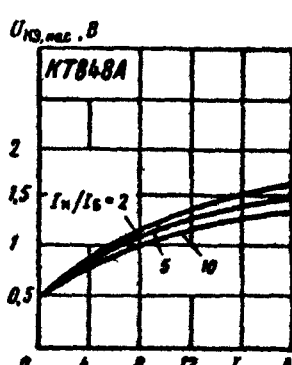
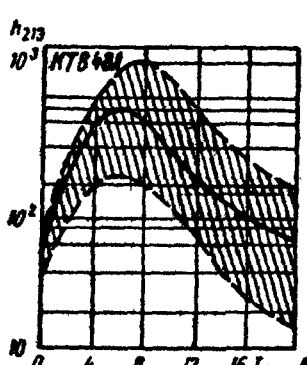
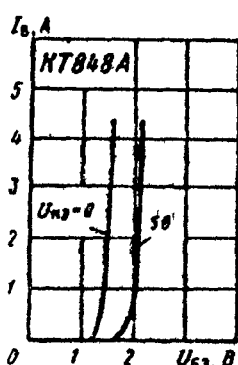
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=5$ В, $I_k=15$ А, не менее:	
$T=+25 \dots +100^\circ\text{C}$	20
$T=-45^\circ\text{C}$	10
Граничное напряжение при $I_k=5$ А, $L=1,5$ мГн, не менее	400 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k=10$ А, $I_b=0,15$ А, не более:	
$T=+25^\circ\text{C}$	2 В
$T=-40^\circ\text{C}$	4,5 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k=7$ А, $I_b=0,07$ А	1*...1,3*...1,5 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k=10$ А, $I_b=0,15$ А:	
$T=+25^\circ\text{C}$	1,7*...1,95*...2,7 В
$T=-40^\circ\text{C}$	1,5*...2,1*...3,5 В
Прямое напряжение диода при $I_{пр}=10$ А, не более	2 В
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{кэ}=400$ В, $R_{бэ}=1$ кОм, не более:	
$T=-45 \dots +25^\circ\text{C}$	3 мА
$T=+100^\circ\text{C}$	5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер	400 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	15 В
Постоянный ток коллектора	15 А
Постоянный ток базы	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	35 Вт
Температура <i>р-п</i> перехода	$+150^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	$-45^\circ\text{C} \dots T_{кр} = +100^\circ\text{C}$

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

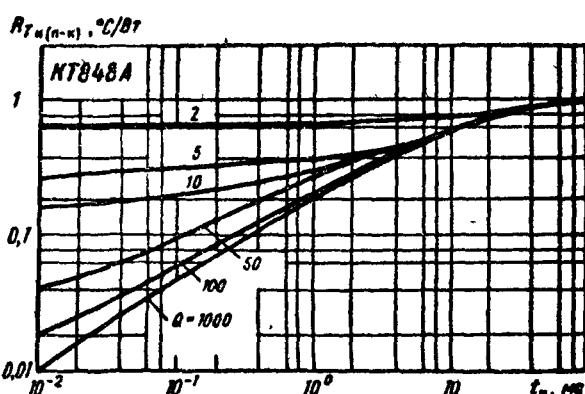
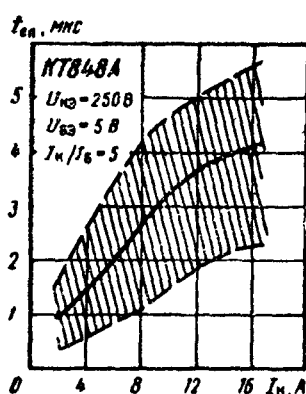
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре $+260^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с, время лужения 2 с.



Входные характеристики

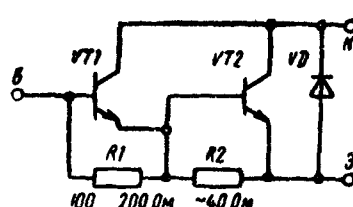
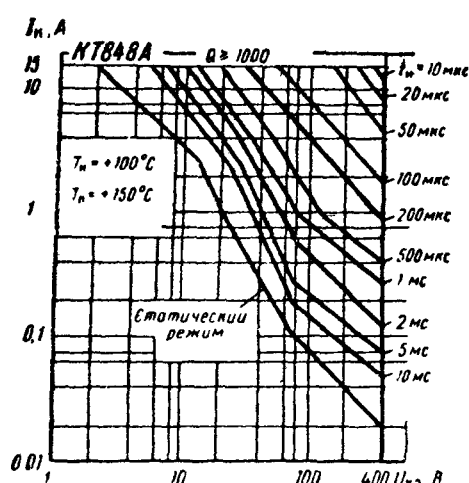
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от импульсного тока коллектора

Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от импульсного тока коллектора



Зона возможных положений зависимости времени спада от тока коллектора

Зависимость импульсного теплового сопротивления переход — корпус от длительности импульса



Области максимальных режимов

Электрическая схема транзистора